



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर  
Indian Institute of Technology Bhubaneswar

प्रेस विज्ञप्ति

**SiCSem भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए  
आईआईटी भुवनेश्वर के साथ सहयोग करेगा**

भुवनेश्वर, 15 जून 2024: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भुवनेश्वर और सीआईसीएसईएम प्राइवेट लिमिटेड ने कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत की जाने वाली पहली परियोजना आईआईटी भुवनेश्वर में सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) क्रिस्टल का स्वदेशी विकास होगा। रुपये की अनुमानित लागत के साथ, 45 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 150 मिमी और 200 मिमी SiC वेफर्स के उच्च मात्रा में उत्पादन की जानकारी लाएगी। SiCSem प्राइवेट लिमिटेड ने ओडिशा में SiC प्रक्रिया निर्माण और एटीएमपी संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे भारत को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), फास्ट चार्जर, हरित ऊर्जा, पीवी इनवर्टर, मोटर नियंत्रण और 5जी संचार से परे उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए पावर सेमीकंडक्टर उपकरणों में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

आईआईटी भुवनेश्वर के निदेशक और सेमीकंडक्टर उपकरणों के विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीपाद कर्मलकर ने कहा कि यह सहयोग SiC क्रिस्टल विकास में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, और आईआईटी भुवनेश्वर के लिए एक प्रमुख उद्योग-अकादमिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। यह सहयोग भारत सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप ओडिशा में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र और देश के सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

-----